

실험 9 증가형 MOSFET의 전류-전압 특성

- 이름 :
- 실험일 :

시뮬레이션 9-1 | N-채널 MOSFET의  $I_D - V_{DS}$  특성 해석하기

표 9-2 N-채널 MOSFET의  $I_D - V_{DS}$  특성 시뮬레이션 결과

$I_D$ [mA]		$V_{DS}$ [V]					
		0.1	0.4	0.8	2.0	4.0	5.0
$V_{GG}$ [V]	1.0						
	2.0						
	2.5						
	3.0						
	3.5						



그림 9-10 N-채널 MOSFET의  $I_D - V_{DS}$  특성 시뮬레이션 결과 파형

시뮬레이션 9-2 | N-채널 MOSFET의  $I_D - V_{GS}$  특성 해석하기

표 9-3 N-채널 MOSFET의  $I_D - V_{GS}$  특성 시뮬레이션 결과( $V_{DS} = 4V$ )

$I_D$ [mA]	$V_{GG}$ [V]								
	0.4	1.0	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0

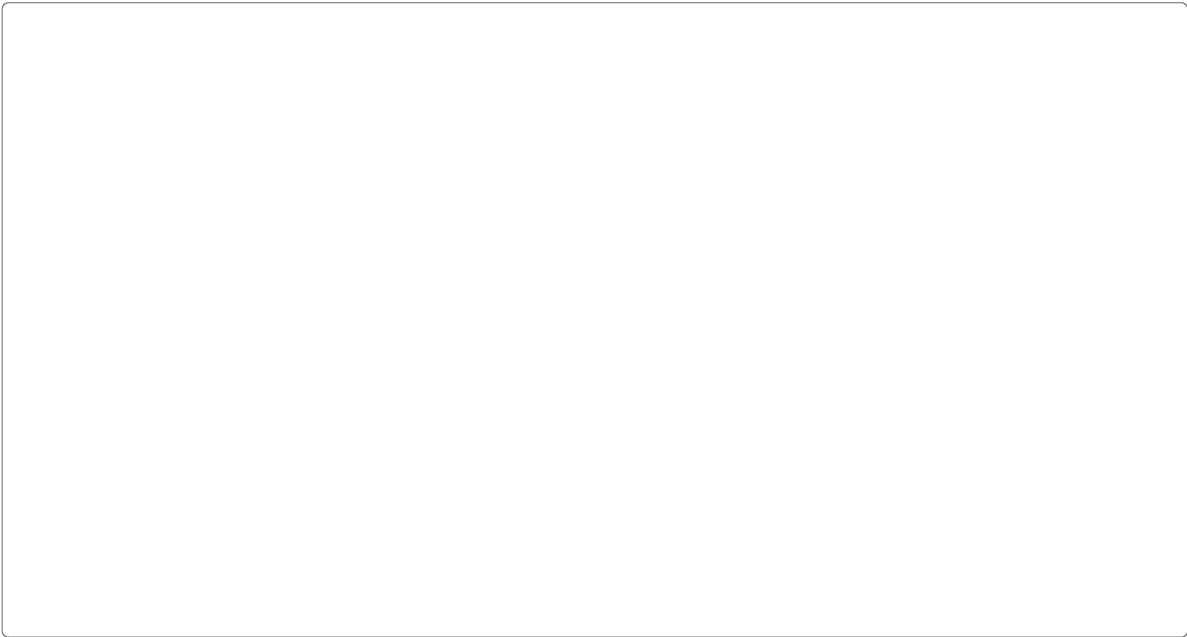


그림 9-11 N-채널 MOSFET의  $I_D - V_{GS}$  특성 시뮬레이션 결과 파형

## 시뮬레이션 회로

### ■ 시뮬레이션 9-1 회로



### ■ 시뮬레이션 9-2 회로

